模拟卢瑟福实验室的实验以检验理论模拟*

乔秀梅¹) 张国平²) 张覃鑫²)

1)(中国工程物理研究院北京研究生部,北京 100088)
 2)(北京应用物理与计算数学研究所,北京 100088)
 (2005年6月1日收到,2005年7月21日收到修改稿)

在亚稳态电子碰撞激发系列程序的基础上研制成功了瞬态电子碰撞激发的系列程序,并用此系列程序模拟了 卢瑟福实验室 2000 年的类氖锗瞬态电子碰撞激发 19.6mm X 射线激光实验,与实验数据的比较表明,模拟结果与实 验基本符合,为以后研究瞬态电子碰撞激发机理打下了基础.

关键词:X射线激光, 瞬态电子碰撞激发, 类氖锗, 亚稳态 PACC: 4255V, 5250J, 8220W

1.引 言

自从 1984 年美国利弗莫尔国家实验室(LLNL) 成功地演示类氖硒电子碰撞激发 X 射线激光以 来¹¹ X 射线激光的研究取得了很大进展²¹ 瞬态电 子碰撞激发机理^{3-5]}极大地降低了抽运能量,提高 了实验的重复频率,小型、高效的"台式"软 X 射线 激光已经成为现实,瞬态电子碰撞激发机理也很有 希望实现水窗波段 X 射线激光,目前采用这种机 理 最短波长已经做到了 7.9nm 的饱和输出^[6].在 XRL 理论研究中,由一维非平衡辐射流体力学 IB19 程序,一维反转动力学 ALPHA 程序和二维几何光学 旁轴近似下 XRL 传播和小讯号放大 XBPA 程序所组 成的模拟 XRL 全过程的程序系列被研制成功,并用 国内外的实验数据进行检验^[7]在一个 ns 长脉冲驱 动下 类氖锗 19.6nm 23.2nm 和 23.6nm 线与实验符 合 在多个短脉冲驱动时 理论模拟除了与严重过电 离的复合等离子体有关的实验外,与实验数据也基 本符合,在亚稳态电子碰撞激发机理的反转动力学 程序 ALPHA 的基础上,开发了类氖锗的瞬态电子碰 撞激发的程序 我们用系列程序模拟了卢瑟福实验 室 2000 年进行的类氖锗 19.6nm 的瞬态电子碰撞激 发的 X 射线激光的实验^[6],并与他们的结果进行了 比较 本文介绍模拟的结果.

2. 瞬态电子碰撞激发的电离和反转动 力学程序 N6

类氖锗的瞬态电子碰撞激发的反转动力学程序 N6 是在亚稳态程序 ALPHA 的基础上,主要由北京 应用物理与计算数学研究所 x 射线激光研究组张 覃鑫开发的 考虑了从锗原子到裸锗原子核共 33 个 电离度的离子 ,162 个细致组态 ,考虑了类氖主量子 数到 3 的 37 个细致组态 ,类氟 113 个细致组态 ,类 钠的主量子数到4的12个细致组态 高能级和其他 离子的能级的主量子数最大为 10 ,主要考虑的原子 过程包括电子碰撞激发、电子碰撞电离、光电离以及 它们的逆过程 以及能级之间的线跃迁 程序中没有 考虑双激发态 考虑了类氟离子的基态到类氖离子 各能级、类氖离子基态到类钠离子各能级的双电子 复合过程,用逃逸概率近似考虑了共振线的俘获效 应对下能级粒子占据数的影响,各细致组态能级的 能量以及电子碰撞激发和自发辐射跃迁系数由北京 应用物理与计算数学研究所原子参数组提供 高能 级和其他离子的能级只考虑了主量子数,其能量由 类氢近似得到 电子碰撞激发和电离等原子过程的 速率系数由经验公式得到[8] 利用模拟激光与靶相 互作用的流体力学程序 JB19 解出等离子体的密度 和温度随时间的变化 把这些量与描述能级粒子占

^{*}国家高技术研究发展计划(批准号 863-804-7-1)资助的课题.

3. 模拟卢瑟福实验室的实验[6]

卢瑟福实验室用两束脉宽为 280ps 的钕玻璃激 光横向辐照锗平板靶,一定时间间隔后,2.7ps 的短 脉冲加热产生的预等离子体,两个预脉冲间隔 2ns, 在靶面的强度分别为 10¹² W/cm² 和 10¹³ W/cm²,短脉 冲的强度为 10¹⁵ W/cm²,考虑了不同的预、主脉冲时 间间隔的情况,图 1(b)是输出类氖锗 19.6nm X 射 线激光的能量随延迟时间的变化关系曲线,为了比 较,给出了文献 6 叶的结果(图 1(a)),横坐标是短 脉冲的峰值时刻相对于主预脉冲峰值时刻的延迟时 间,以 ps 为单位,纵坐标是输出 X 射线激光的能量 (μJ),图中对应的靶长为 5nm,图 1(b)表明,延迟时 间为 0ps 时,输出 X 射线激光的能量最大,然后随延 迟时间的增加而减小,这与实验结果一致,与图 1 (a)相比,除了延迟时间为 350ps 以外,我们的模拟 结果比实验值偏低,考虑到实验中测量 X 射线能量 存在一些不确定的因素,我们的模拟结果与实验结 果是符合的.我们看到,最佳的延迟时间是 0ps,为 此可以看看不同延迟时间时等离子体的状态.



图 1 类氖锗 19.6nm X 射线激光的输出能量(μ J)随着超短脉冲峰值与第二个预脉冲峰值之间的时间间隔(ps)之间的变化曲线.(a) 文献 6 的实验结果(b)本文模拟的结果

图 2 是 0 80 ,175ps 延迟时间下,类氖锗 19.6nm X射线激光的增益系数(a),类氖离子的丰度(b)以 及电子密度(c)和电子温度(d)的空间分布,横坐标 是到靶面的距离以 um 为单位,可以看到,短脉冲延 迟不同的时间,在增益区都产生了足够的类氖离子, 延迟时间越长 具有足够类氖离子的区域越宽 这与 等离子体的膨胀有关 因此 影响增益系数的主要因 素就是增益区的电子温度.对于延迟时间为 80ps 来 讲 在临界面附近的峰值增益系数最大 这是因为电 子温度在这个区域最大,但是临界面附近的增益系 数对最终的 X 射线激光的贡献很小,因为在临界面 附近电子密度梯度较大,平均电子密度梯度为-8.9 ×10²³ cm⁻⁴,X 射线激光光线将会被偏折出增益区 (如图 3 所示),因而,对 X 射线激光输出贡献较大 的主要增益区是临界面以下距离靶面约 15µm 到 50µm 的次临界区域,这里电子密度梯度相对要小, 折射效应也较小.对于延迟时间最短的 Ops ,经过同

样的分析可以知道,对 X 射线激光贡献较大的区域 是距离靶面约 20µm 到 50µm 的区域,从图 2(a)和 (d)知道,在预主脉冲延迟时间为 0ps 时,这个区域 的电子温度最大,在这个区域以外,随到靶面的距离 的增加,电子温度迅速减小,电子温度的变化也导致 了增益系数发生同样的变化,因为在增益区,增益系 数很快减小为 0/cm,这就说明预主脉冲之间的延迟时 间取 0ps 要好一些.从图 <u>X</u> e)还可以看到,电子密度 在临界面以上很薄的一层内也达到了较高的值,这是 因为从流体力学程序 JB19 计算的电子密度和反转动 力学程序 N6 计算的结果之间的差异造成的.

图 4 给出了由 Linford 公式^[9]拟合的输出 X 射 线激光强度随靶的长度的变化曲线,其延迟时间是 80ps ,为了方便与实验进行比较,在图 3 和本节的其 他图中 ,靶长均为 9mm ,延迟时间为 80ps .与文献 6] 中的实验结果比较,我们的系列程序模拟的小信号 增益系数大于 30/cm ,输出的总的 X 射线激光的能



图 2 不同延迟时间情况下,类氖锗 19.6nm X 射线激光的增益系数(单位为 cm⁻¹)(a),类氖离子的丰度(b),电子密度(10²² cm⁻³)(c)和电子温度(eV)(d)的空间分布;实线、虚线和点线分别代表延迟时间为 0ps ,80ps 和 175ps.横坐标代表到靶面的 距离单位是 µm,其上的零点代表靶面所在的位置

量为 40.5µJ,略低于实验测得的 100µJ,这可以从几 个方面来解释,一方面从实验的角度看,在测量输出 X射线激光的能量时,由于无法有效地测量输出 X 射线激光的强度在垂直平面的分布,假定垂直方向 的发散角是水平发散角的两倍,这有可能使得测得 的能量偏高,再考虑到实验仪器的误差,实验上能量 测量的精度仅大于 50%;另一方面,从模拟的结果 看 输出 X 射线激光的发散角偏小(见图 5(b)),这 也使得模拟的 X 射线激光的能量偏低.

图 5 是 X 射线激光强度的角分布,可以看出我 们模拟的输出 X 射线激光的折射角是 11.5mrad,发 散角是 6.2mrad,实验值分别为 10mrad 和 9mrad,我 们的发散角比实验值稍微偏小,与实验相比,我们模 拟的输出 X 射线激光的角分布的轮廓与实验结果



图 3 X射线激光在等离子体中不同区域传播的轨迹,入射角度均为 0mrad,预主脉冲的时间间隔是 80ps.可以看到,图(a) 中,X射线激光在等离子体中传播 0.75mm,就被偏折约 4µm,偏折角为 11.5mrad,这说明,临界面附近的这个高增益区对 X 射线激光的贡献非常小,对 X射线激光贡献最大的区域是距靶面 15µm到 50µm 的增益区





图 4 输出 X 射线激光强度(mJ/Sr. 随靶长(cm)的变化 (a)本文模拟的结果(b)实验结果:准行波抽运(+),不采用行波抽运时,靶北端的输出 X 射激光能量(x) 靶的南端输出的 X 射线激光的能量(·)



图 5 输出 X 射线激光强度(任意单位)随折射角(mrad)的变化 (a)实验结果(实线),虚线是文献 6 的模拟结果(b)本文模拟的结果

4.结 论

用新开发的类氖锗的瞬态电子碰撞激发系列程 序模拟了卢瑟福实验室于 2000 年做的类氖锗 19.6nm X 射线激光的实验,我们的模拟结果与实验 基本符合,为以后研究瞬态电子碰撞激发机理提供 了基础.

北京应用物理与计算数学研究所的原子参数组提供了 原子参数 在此向他们表示感谢.

- Matthews D L ,Hagelstein P L ,Rosen M D 1985 Phys. Rev. Lett.
 54 110
- [2] Key M H, 1992, Proc. of the 3rd Intern. Conf. on X-Ray Lasers, Institute of Physics London, 171

Maxon S ,Estabrook K G ,Prasad M K *et al* 1993 *Phys* . *Rev* . *Lett* . **70** 2285

Daido H , Kato Y , Murai K et al 1995 Phys. Rev. Lett. **75** 1074 Daido H , Kodama R , Murai K et al 1995 Opt. Lett. **20** 61 Smith R , Tallents G J , Zhang J et al 1999 Phys. Rev. A **59** R47

- [3] Wang C, Wang W, Wu J et al 2004 Acta Phys. Sin. 53 3752 (in Chinese J 王 琛、王 伟、吴 江等 2004 物理学报 53 3752]
- [4] Wang C , Wang W Sun J R et al 2005 Acta Phys. Sin. 54 202 (in

Chinese [王 琛、王 伟、孙今人等 2005 物理学报 54 202]

 [5] Nickles P V, Shlyaptsev V N, Kalachnikov M et al 1997 Phys. Rev. Lett. 78 2748
 Dunn J, Osterheld A L, Shepherd R et al 1998 Phys. Rev. Lett 78

2825 Ozaki T , Ganeev R A , Lshizawa A *et al* 2002 *Phys*. *Rev*. *Lett* **89** 253902

- [6] King R E , Pert G J , McCabe S P et al 2001 Phys. Rev. A 64 053810
- [7] Zhang G P , Zhang T X , Zheng W D High Power Laser and Particle Beams 2004 16 35

Zhang G P , Zhang T X , Zheng W D High Power Laser and Particle

Beams 2004 16 171 [8] Lee Y T 1987 JQSRT 38(2)131 [9] Linford G J, Peressini E R, Soody W R et al 1974 Appl. Opt. 13 379

Modeling RAL experiment to test our simulation *

Qiao Xiu-Mei¹) Zhang Guo-Ping²) Zhang Tan-Xin²)

1 🕽 Graduate School of China Academy of Engineering Physics , Beijing 100088 , China)

2 X Institute of Applied Physics and Computational Mathematics , Beijing 100088 , China)

(Received 1 June 2005; revised manuscript received 21 July 2005)

Abstract

A code series for transient collisional excitation (TCE) was newly developed based on the previous code series for QSS scheme, the TCE Ne-like Ge 19.6nm X-ray laser experiment done by RAL in 2000 was modeled to test our code series, a relatively good fit is obtained which provides convenience for our study of TCE scheme.

Keywords : X-ray laser , transient collisional excitation , Ne-like Ge , QSS PACC : 4255V , 5250J , 8220W

^{*} Project supported by the National High Technology Research and Development Program of China Grant No. 863-804-7-1).